

PCT

国際調査報告

(法8条、法施行規則第40、41条)
〔PCT18条、PCT規則43、44〕

出願人又は代理人 の書類記号 - 32903052	今後の手続きについては、国際調査報告の送付通知様式(PCT/ISA/220) 及び下記5を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JPO3/10456	国際出願日 (日.月.年) 19.08.03	優先日 (日.月.年) 20.08.02
出願人 (氏名又は名称) 独立行政法人産業技術総合研究所		

国際調査機関が作成したこの国際調査報告を法施行規則第41条(PCT18条)の規定に従い出願人に送付する。
この写しは国際事務局にも送付される。

この国際調査報告は、全部で 3 ページである。

☐ この調査報告に引用された先行技術文献の写しも添付されている。

1. 国際調査報告の基礎

- a. 言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願がされたものに基づき国際調査を行った。
☐ この国際調査機関に提出された国際出願の翻訳文に基づき国際調査を行った。
- b. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際調査を行った。
☐ この国際出願に含まれる書面による配列表
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された書面による配列表
☐ 出願後に、この国際調査機関に提出された磁気ディスクによる配列表
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった。
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

2. ☐ 請求の範囲の一部の調査ができない(第I欄参照)。

3. ☐ 発明の単一性が欠如している(第II欄参照)。

4. 発明の名称は ☒ 出願人が提出したものを承認する。
☐ 次に示すように国際調査機関が作成した。

5. 要約は ☒ 出願人が提出したものを承認する。
☐ 第III欄に示されているように、法施行規則第47条(PCT規則38.2(b))の規定により国際調査機関が作成した。出願人は、この国際調査報告の発送の日から1カ月以内にこの国際調査機関に意見を提出することができる。

6. 要約書とともに公表される図は、
 第 1 図とする。 ☒ 出願人が示したとおりである。 ☐ なし
☐ 出願人は図を示さなかった。
☐ 本図は発明の特徴を一層よく表している。

A. 発明の属する分野の分類 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.

H01L27/10 H01L27/115 H01L29/78

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料 (国際特許分類 (IPC))

Int. Cl.

H01L27/10 H01L27/115 H01L29/78

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報 1922-1996年
 日本国公開実用新案公報 1971-2003年
 日本国実用新案登録公報 1996-2003年
 日本国登録実用新案公報 1994-2003年

国際調査で使用了電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語)

IEEE explore
 ISI Web of Science
 Elsevier Sciencedirect

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	Choi, H. S. et.al. Electric Characteristics of Pt/SrBi ₂ Ta ₂ O ₉ /Ta ₂ O ₅ /Si Using Ta ₂ O ₅ as the Buffer Layer. Japanese Journal of Applied Physics, April 2001, Vol. 40, Part 1, No. 4B, pp. 2940-2942	1-11, 18-20, 23
Y	Choi, K. J. et.al. Metal/ferroelectric/insulator/semiconductor structure of Pt/SrBi ₂ Ta ₂ O ₉ /YMnO ₃ /Si using YMnO ₃ as the buffer layer. Applied Physics Letters, 2 August 1999, Vol. 75, No. 5, pp. 722-724	1-11, 18-20, 23

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」 特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
 「E」 国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
 「L」 優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献 (理由を付す)
 「O」 口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
 「P」 国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」 国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
 「X」 特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
 「Y」 特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
 「&」 同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

26.12.03

国際調査報告の発送日

20.01.04

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁 (ISA/JP)
 郵便番号 100-8915
 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官 (権限のある職員)

小川 将之



4M

9634

電話番号 03-3581-1101 内線 3462

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
Y	US 6060755 A (Sharp Laboratories of America, Inc.) 2000.05.09, 全文, 全図 & JP 2001-77111 A, 全文, 全図 & TW 463385 A & EP 1179837 A2	1-2, 5, 9-11, 14-15, 18-20, 23
Y	Cho, H. J. et. al. Structural and Electrical Properties of HfO ₂ With Top Nitrogen Incorporated Layer. IEEE Electron Device Letters, May 2002, Vol.23, No.5, pp. 249-251	6, 8
PX	US 2003/027360 A1 (Sharp Laboratories of America, Inc.)	1, 9
PY	2003.02.06, 全文, 全図 & JP 2002-329847 A, 全文, 全図 & KR 2077181 A	2, 5-8, 19-20 23
PY	Choi, C. H. et. al. Thermally Stable CVD HfO ₂ N, Advanced Gate Dielectrics with Poly-Si Gate Electrode. IEDM Technical Digest, December 2002, pp. 857-860	3-4, 6-7, 19- 20